Tabela 1. Pomiar charakterystyk przejściowych $I_D=f(U_{GS})|U_{DS}=const$ tranzystora polowego MOS SMY 50

Lp	U_{GS}[V]	U_{DS1}=-1 V $U_R=0$V	U_{DS2}=-2 V $U_R=0$V	U_{DS3}=-3 V $U_R=0$V	U_{DS4}=-4 V $U_R=0$V	U_{DS2}=-2 V $U_R=5$V
		I_D[mA]	I_D[mA]	I_D[mA]	I_D[mA]	I_D[mA]
1.	U_T =					
2.						
3.	-6,0					
4.	-6,5					
5.	-7,0					
6.	-7,5					
7.	-8,0					
8.	-8,5					
9.	-9,0					
10.	-9,5					
11	-10,0					
12.	-10,5					
13.	-11,0					
14.	-11,5					
15.	-12,0					

Grupa : ……. Skład osobowy : ……

Zespół: ……. ……

……

……

……

data i podpis prowadzącego zajęcia

Tabela 2. Pomiar charakterystyk wyjściowych $I_D=f(U_{DS})|U_{GS}=const$ tranzystora polowego MOS SMY 50

Lp	U_{DS}[V]	U_{GS1}= -6 V $U_R=0$V	U_{GS2}= -7 V $U_R=0$V	U_{GS3}= -8 V $U_R=0$V	U_{GS4}= -9 V $U_R=0$V	U_{GS2}= -7 V $U_R=5$V
		I_D[mA]	I_D[mA]	I_D[mA]	I_D[mA]	I_D[mA]
1.	-100m					
2.	-200m					
3.	-0,4					
4.	-0,6					
5.	-0,8					
6.	-1,0					
7.	-2,0					
8.	-3,0					
9.	-4,0					
10.	-5,0					
11	-6,0					
12.	-7,0					
13.	-8,0					
14.	-9,0					
15.	-10,0					

Grupa : ……. Skład osobowy : ……

Zespół: ……. ……

……

……

……

data i podpis prowadzącego zajęcia